

大見研究室 和文 論文リスト

2012 年

- 1245(W) 【基調講演】大見忠弘、長谷部類、吉田達郎、内村徹平、添田一喜、平塚亮輔、吉川和博、須川成利、村川順之、「シリコン表面の室温三工程洗浄と超高速ウェットエッチングによるシリコン基板薄化技術」、表面科学技術研究会 2012 水と表面 表面のウェット・ナノプロセスの最前線—固液反応、水・洗浄・加工・計測技術—、pp.1-27、2012 年 1 月。
- 1246(W) 諏訪智之、熊谷勇喜、寺本章伸、木下豊彦、室隆桂之、須川成利、服部健雄、大見忠弘、「酸素ラジカルと酸素分子を用いて形成した SiO_2/Si 界面における構造遷移層の相違」。ゲートスタック研究会—材料・プロセス・評価の物理—第 17 回研究会、((社)応用物理学会 薄膜・表面物理分科会/シリコンテクノロジー分科会共催)、pp.141-144、2012 年 1 月。
- 1247(C) 大見忠弘、「日本の半導体産業再建へのシナリオ～学問に基づく本物のシリコン産業の創出～」、第 73 回応用物理学会学術講演会 特別シンポジウム、(応用物理学会主催国際会議 SSDM 実行委員会)、pp.3-1～3-22、2012 年 9 月。
- 1248(C) 永田晃基、山口拓也、小椋厚志、小金澤智之、廣澤一郎、諏訪智之、寺本章伸、服部健雄、大見忠弘、「微小角入射 X 線回折による熱酸化およびラジカル酸化 SiO_2 薄膜中の結晶様構造の評価」、第 73 回応用物理学会学術講演会 講演予稿集、(公益社団法人応用物理学会)、13-086、(12p-F4-14)、DVD、2012 年 9 月。
- 1249(C) 辻幸洋、中村健一、眞壁勇夫、中田健、勝山造、寺本章伸、白井泰雪、須川成利、大見忠弘、「窒化ガリウム表面における汚染粒子除去洗浄の検討」、第 73 回応用物理学会学術講演会 講演予稿集、(公益社団法人応用物理学会)、15-215、(14a-H10-8)、DVD、2012 年 9 月。
- 1250(M) 白井泰雪、今泉文伸、白鳥賢、大見忠弘、「東北大学未来情報産業研究館における東日本大震災の影響」、Journal of the Vacuum society of Japan 真空、Vol.55、No.9、(一般財団法人日本真空学)、pp.409-412、2012 年 9 月。
- 1251(W) 諏訪智之、寺本章伸、室隆桂之、木下豊彦、須川成利、服部健雄、大見忠弘、「 $\text{SiO}_2/\text{Si}(100)$ 界面における組成遷移層に関する研究」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.112、No.263、シリコン材料・デバイス(電子情報通信学会)、SDM2012-89、pp.1-4、2012 年 10 月。
- 1252(W) 永田晃基、山口拓也、小椋厚志、小金澤智之、廣澤一郎、諏訪智之、寺本章伸、服部健雄、大見忠弘、「微小角入射 X 線回折を用いた SiO_2 薄膜中の結晶相の評価」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.112、No.263、シリコン材料・デバイス(電子情報通信学会)、SDM2012-91、pp.11-14、2012 年 10 月。
- 1253(W) 中尾幸久、寺本章伸、黒田理人、諏訪智之、田中宏明、須川成利、大見忠弘、「PECVD 法を用いたゲートスペーサー用高品質シリコン窒化膜の低温形成プロセス」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.112、No.263、シリコン材料・デバイス(電子情報通信学会)、SDM2012-93、pp.21-26、2012 年 10 月。
- 1254(W) 【特別講演】大見忠弘、中尾幸久、黒田理人、諏訪智之、田中宏明、須川成利、「シリコン LSI:微細化に替る高性能化の道」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.112、No.263、シリコン材料・デバイス(電子情報通信学会)、SDM2012-94、pp.27-32、2012 年 10 月。
- 1255(W) 酒井健、吉田達朗、吉川和博、大見忠弘、「シリコンウェーブプロセスにおける超高速化ウェットエッチング技術」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.112、No.263、シリコン材料・デバイス(電子情報通信学会)、SDM2012-97、pp.41-45、2012 年 10 月。
- 1256(W) 諏訪智之、寺本章伸、室隆桂之、木下豊彦、須川成利、服部健雄、大見忠弘、「 $\text{SiO}_2/\text{Si}(100)$ 界面における組成遷移層の解明」、第 24 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.25-30、2012 年 11 月。

- 1257(W) 大見忠弘、中尾幸久、黒田理人、宮本直人、小谷光司、平山昌樹、後藤哲也、須川成利、「シリコン LSI 性能向上の新しい方向」、第 24 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.59-82、2012 年 11 月